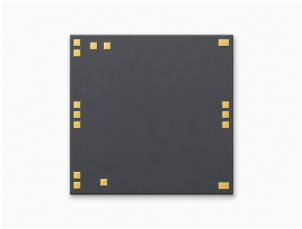
Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 8000–8400 MHz

LCI-PA-8000-8400-PS45T es un amplificador de potencia GaN MMIC en formato de die sin encapsular para 8000–8400 MHz. Admite funcionamiento en CW y pulsado.



Valores de la tabla RF: Potencia de salida saturada: 45 dBm (típico); Ganancia de potencia: 23 dB (típico); Eficiencia de potencia añadida: 55 % (típico). Condiciones de ensayo RF: TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -3 V. Dimensiones del die: 2.9 × 2.8 × 0.1 mm.

Características RF

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -3 V

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Frecuencia de funcionamiento	f	8000	-	8400	MHz
Potencia de salida saturada	Psat	-	45	-	dBm
Ganancia de potencia	Gp	-	23	-	dB
Planitud de la ganancia de potencia	ΔGp	-	-	±0.5	dB
Eficiencia de potencia añadida	PAE	-	55	-	%
Ganancia de pequeña señal	S21	-	33	-	dB
Planitud de la ganancia de pequeña señal	ΔS21	-	-	±1	dB
VSWR de entrada	VSWR(in)	-	1.2	1.3	-

Polarización DC y corrientes

TA = +25 °C

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Tensión de drenador	Vd	-	28	32	V
Tensión de puerta	Vg	-3	-3	-2.6	V
Corriente de drenador en reposo	Id	-	0.8	-	A
Corriente dinámica de drenador	Idd	-	2.3	2.6	A
Corriente dinámica de puerta	Igg	-	0.2	1	mA

Valores límite

Valores límite; no son consignas de funcionamiento normal.

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Tensión drenador-fuente máxima	Vd	-	-	32	V
Polarización de puerta mínima	Vg	-5	-	-	V

Valores límite

Valores límite; no son consignas de funcionamiento normal.

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Potencia de entrada máxima	Pin	-	-	26	dBm
Temperatura máxima del canal	Top	-	-	225	°C
Temperatura de almacenamiento	TSTG	-65	-	150	°C

Dimensiones del chip

Parámetro	Valor	Unidad
Dimensiones del die	2.9 × 2.8 × 0.1	mm
Tolerancia del contorno en planta	±100 (Solo contorno en planta; no se especifica la tolerancia del espesor.)	µm

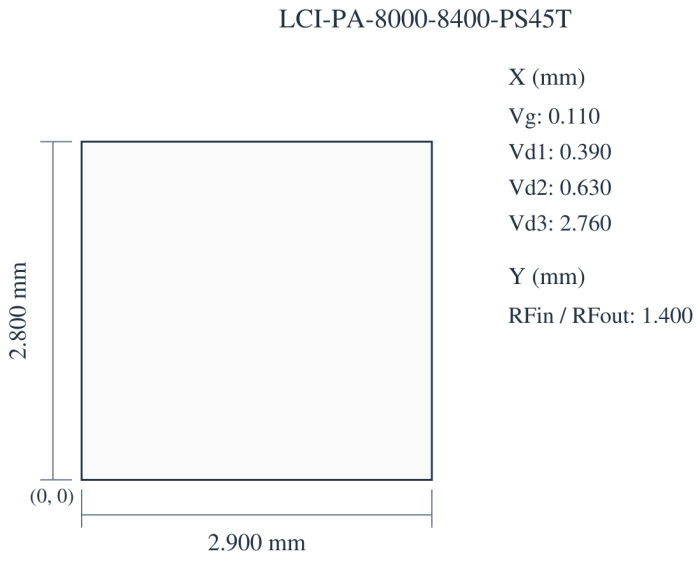
Registro de la publicación actual · 1.9 · 2026-11-12. Actualización de la descripción o del contenido editorial. Sustituye a la revisión 1.8.

Integración del chip y secuencia de polarización

Al encender, aplicar la polarización de puerta antes que la de drenador. Al apagar, retirar primero la del drenador. Manipular en un entorno limpio con protección ESD y utilizar un soporte con expansión térmica compatible con el die de SiC.

Plano dimensional mecánico

Contorno y coordenadas acotadas en mm. Este plano sirve como referencia dimensional. Para la fabricación y el conexionado por hilo se requieren planos completos.



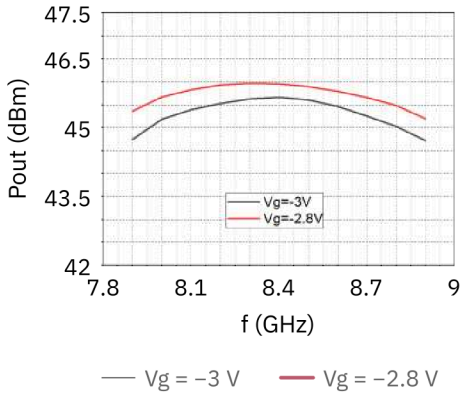
2.900 × 2.800 × 0.100 mm
X, Y: ±0.100 mm
X → · Y ↑ · X, Y: mm

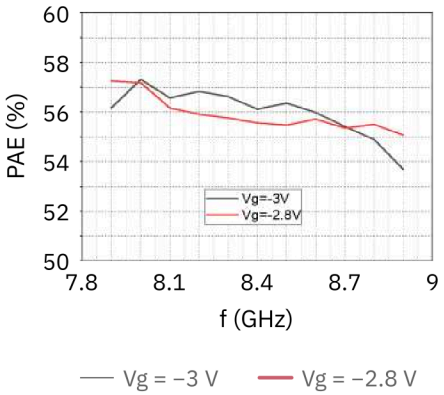
Curvas de rendimiento

Cada gráfica de rendimiento corresponde a las condiciones de funcionamiento que indica.

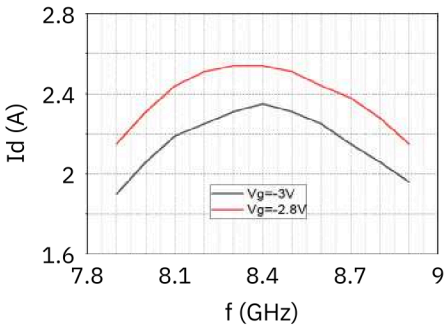
Pulsado — Potencia de salida saturada; Eficiencia de potencia añadida; Corriente dinámica de drenador; Adaptación de entrada; Ganancia.

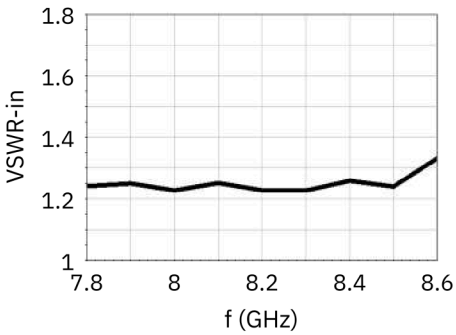
Notas de la figura: TA = +25°C; Vd=+28V.



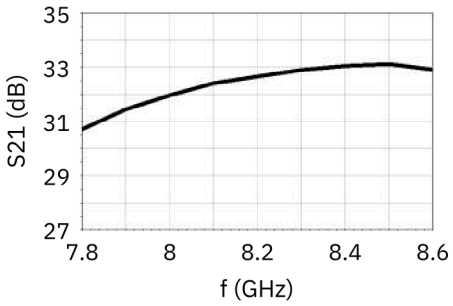


Vg = −3 V Vg = −2.8 V Vg = −3 V Vg = −2.8 V



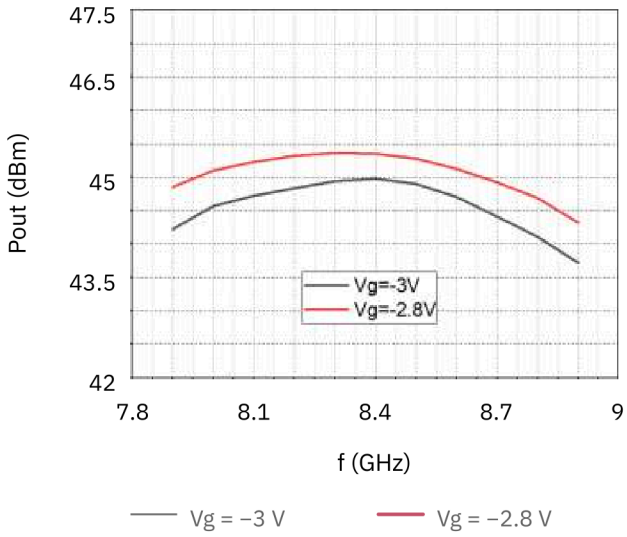


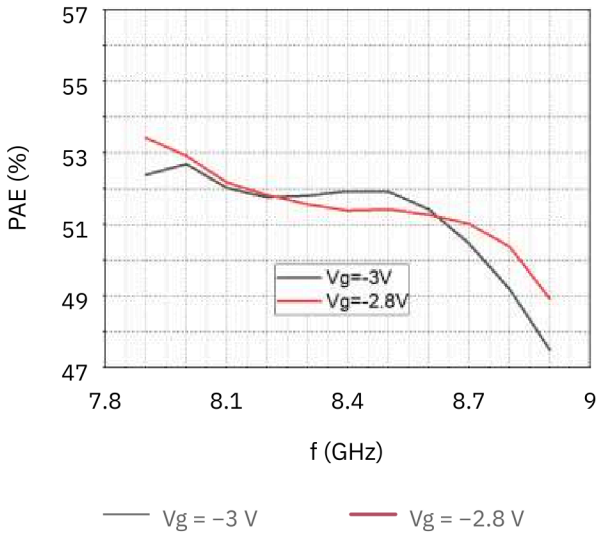
Vg = −3 V Vg = −2.8 V

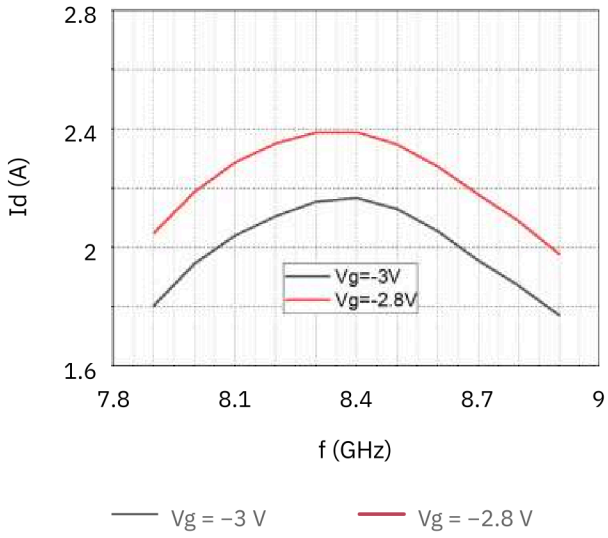


Onda continua (CW) — Potencia de salida saturada; Eficiencia de potencia añadida; Corriente dinámica de drenador.

Notas de la figura: TA = +25°C; Vd=+28V; Pin=22dBm.

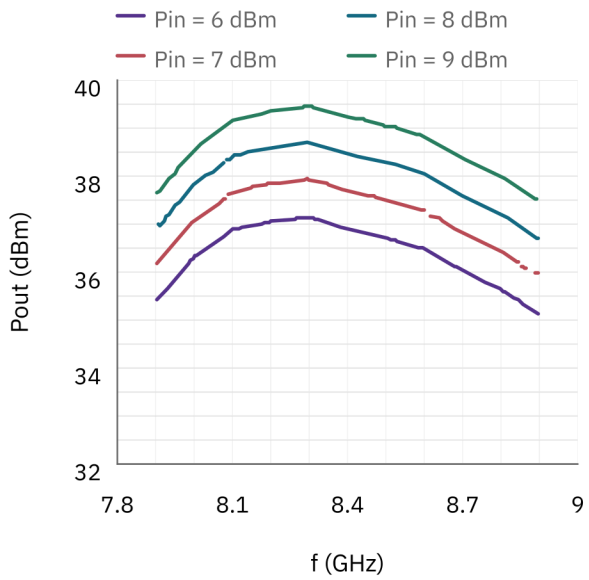


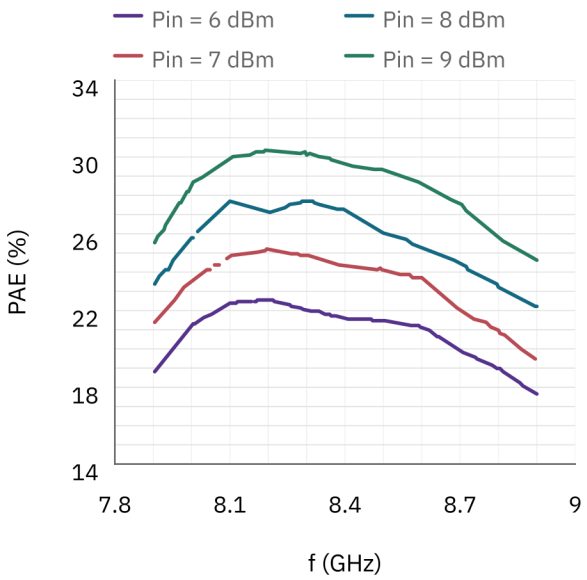


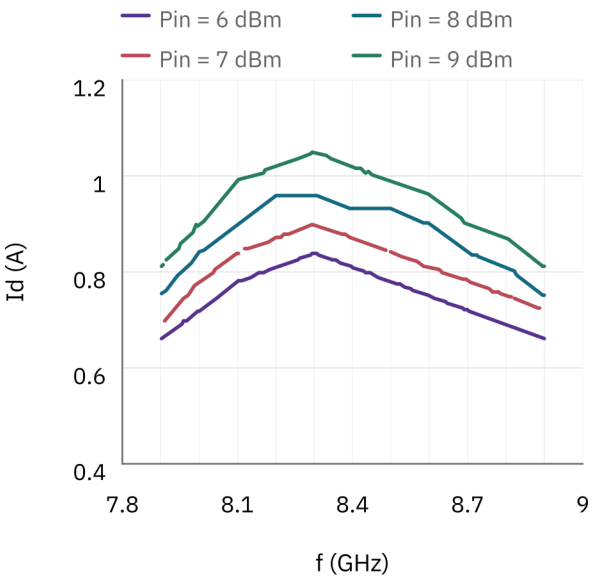


Pulsado — Potencia de salida con reducción de potencia; Eficiencia de potencia añadida; Corriente dinámica de drenador.

Notas de la figura: TA = +25°C; Vd=+28V; Vg=-3.0V. Las lecturas son aproximadas. Pin = 6 / 7 / 8 / 9 dBm. Leer cada traza con las condiciones indicadas en su gráfica. Ancho de pulso = 100 µs; ciclo de trabajo = 10%.







Aviso del documento

Las especificaciones pueden revisarse. Antes de cerrar el diseño, confirme con LCRF la revisión vigente y los requisitos específicos del producto. La oferta aprobada y la documentación del pedido definen la configuración suministrada.